

"#z,+ \$ IGBT 18N G ÄEîE› /ÆL6,+ \$ {•A'AuP`A•
ä Ñ Y1 Ô 5` HEîE› v {•A'AuP`A•,X IGBT 18N4“

+ Ñ/¥ :L6,+ \$-è0J Ä 1 ß1T/Ä “ /ÆL6,+ \$ ” ÅA'Au-è ¥,X4±4ì Ù { U
J'1u Ä“Insulated Gate Bipolar Transistor È1T/Ä IGBT” Å2İ ë {•b 1!ü "#z
,+ \$ ÝL\$ @ ì Ä 1 ß1T/Ä“ "#z,+ \$ ” Å,X 18N G Ä Þ# (ä s È ØNM – D E'
A'Au?U" È Û «- "#z,+ \$ 1 Ý Z Ñ Y1 Ô 5` HEîE› v {•A'AuP`A•,X IGBT
18N4“ È •!7 š Û Ü 0 1 E- Ô!9 || Ñ {7¾ IGBT {•,X û MG£*ó {E-/ß È 1
}|E- r),, Ñ Y IGBT {î ê,X,Ä Û Ä

E- õ# (ä s,X {•G›*ü Planar NPT < È4\$ X È?~ 15-43A /1200V ÄE- Þ {•
M6 ä Š*ü+ < h*üNZ ³ È,Ä !!7+ Ñ Y:+ á,X Š+ Ô î v A©*üA~ Ä

"#z,+ \$ ÝL\$ @ ì KS ó 1 9 x õ { :-è Ü 0,X õ ä È ä Ñ Y:+ á/¥-èL6 ž û :
ü „_+ o+ \$ < È •M6,X T Ü 0+ 9 Æ Ä ü!8 IGBT NM,Ä Ü 0!È •Ö6(
Ü+ \$/¥ T û :+ AË J ä s9<k Z Ñ Š „_+ o+ \$NM,Ä,X Ô Ä ü IGBT NM,Ä k
L !%o û ä p È È •Ú4»4Á ¥ ù Ø7¾,X ì “ ÈE- Ô!9 ü Ù Ä IGBT 1 •M6,X8V
6ÑL!5ëNZ ³) Ô š Û,X Ü 0 Ä

B Ñ Y Ô,X Ö Ax 1 XC m È 2009 H Ñ IGBT ,X Ö ?~ õE' 38.2 “ Ž!â
Õ ÈNX ó2010 H Ñ IGBT Ö ?~ õ 41.4 “ Ž!â Õ ÈEW 2009 H äKS 8.4% Ä
2011 H â 2012 H Ú ýE' 45.3 â 50.6 “ Ž!â Õ È rKS)[Ú ý 9.4% â
11.7% Ä È Ý Đ' XNX# IGBT ü 2010 H ü Ñ,X äKS ÚE' 25% 1 Þ ÄM6
Í û,X Ö LÔ" È Ñ,Ä !E-“u Ý Ô 5` H,X IGBT *ó {4“ Ä 1 x o4œ0Ä v S
*ü È !8 T MNO qC*E- · Ä

IGBT + U _ J'1u Ä1T/Ä “BJT” Å `4±4ì Ù _ h J'1u Ä1T/Ä “MOSFET” Å
,!4\$ Ü,X+ _PE | ä s)[Đ' < È Ä ¶ Ý s)[MOSFET Eg 9L kP- È { s)[
ã È ç bPE | È { 1T) Ä Ô GNe)[P-,X ì&• È œ Ý U J'1u,X ĐEî+ _" ÈEî
Õ+ # û È 35ë ä,X :+ ì&• Ä ü x õ8V6Ñ £ f Ä ".‡4£#",X È · È K Û8V6Ñ) [
P- È “ b?~ õ ê*ó { ÈEW ç r),,8V6Ñ N ; ê1 ì&•,X IGBT Æ ä s)[Đ' Ö
¥),X # T ÄIGBT ?U*ü ü Š+ {•Ä 1 î { Ä5%4°Eî Ä'; â Ä#C + \$ Ä
Au1k ž"QE:+ \$1 È5à N6Ñ+ 5% ÄP-ÉóJ•CÄ Ä „6Ñ\$d"QE: IGBT ÔEs Z È t S
"-,X h*ü Ö Ä

■ G b "#z,+ \$

"#z,+ \$ ž JL 2 @ ì ÑNZ ,X õ³ Đ' @ ì È J î u Ù À Ô ã J Ú .
1 ÃLš ä+ CÃA' Au ÃLš ä+ CÃ Õ>™# A© ` Ú0ÿ < Ê - û Đ' î u S + Ä "#z,+
\$ Om\$ S P Ö @ ì Ä 0597.HK Å È2008 H z9ù îNq 31.18 "\$ Õ È Ñ Y!
h û Đ' Eô Ô Ä

■ G b /¥L6,+ \$

/¥L6,+ \$ Ô çK¼ ç _ ,+ \$NZ ³-è0J â Ô ¥,X Ñ0ÿ-è0J X È ü î p •
â Ø b Ñ YNZ ! È ^ k Z .),X ä p È Ñ,+ \$ T ` { î ¥) 0 Î Z G i
?UBõ) ÄA¹ ü VDMOS ÑIGBT 1 s)[< Ê NZ ³,X-è Ý ` î H,X T /Ã3 ` î
. È,Ä !!77È o bM6 â N6Ñ+ 5% `+ |"QE:P-0Ã h*üNZ ³,X IGBT 2ï ë { • Ô ¥ Ä

„Kï6(2ï Ž Ö

"#z,+ \$ ÝL\$ @ ì /B)
+ A± Ö (+86-510) 8180 5021
Ö (+86) 1381203 1495
ô,ó Ö (+86-510) 8580 4647
+ \$F,1... Ö chengj@crmh.com.cn